



## 电子

优于大市（维持）

### 证券分析师

陈海进

资格编号：S0120521120001

邮箱：chenhj3@tebon.com.cn

### 研究助理

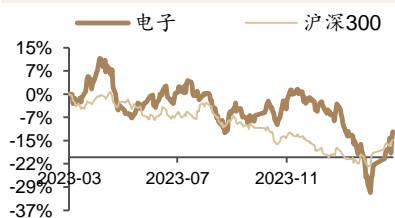
徐巡

邮箱：xuxun@tebon.com.cn

谢文嘉

邮箱：xiewj3@tebon.com.cn

### 市场表现



### 相关研究

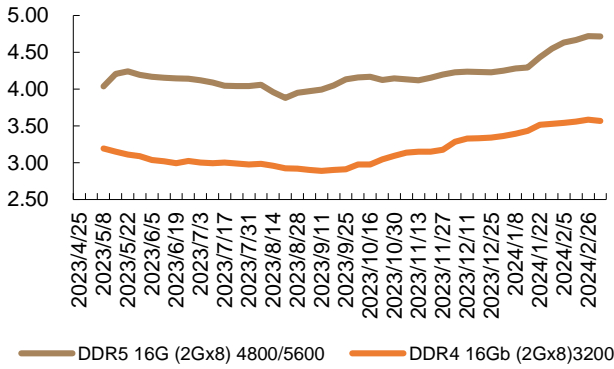
- 《存储价格周度跟踪-0226: DRAM 颗粒品项零星成交, NAND 现货市场陆续回温》, 2024.2.27
- 《电子周观点: 英伟达业绩超预期, 持续聚焦算力》, 2024.2.25
- 《存储价格周度跟踪-0219: DRAM 价格持续上涨, NAND 需求逐渐转强》, 2024.2.19
- 《电子月报(台股)2024-1: 电子需求复苏, AI 贡献增量》, 2024.2.18
- 《电子周观点: Sora 视频模型横空出世, 算力需求有望持续增长》, 2024.2.17

# 存储价格周度跟踪-0303: DRAM 颗粒价格短期调整, NAND 价格上涨

## 投资要点:

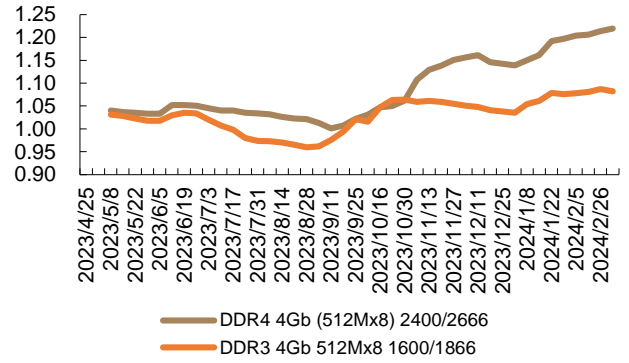
- DRAM: DRAM 颗粒价格出现短期调整, 供应商卖压加剧。**根据 DRAMexchange, 上周 (0226-0303) DRAM18 个品类现货价格环比涨跌幅为-1.1%~+3.0%, 平均涨跌幅为 0.0%, 前值为+0.9%。上周 5 个料号呈上涨趋势, 13 个料号呈下降趋势, 无料号价格持平。虽然原厂控货与上调官价, 但仍因终端需求未能好转而停滞, 模组表现亦是相同。现货市场整体呈现观望氛围, 仍需关注后续终端需求变化情况。
- NAND: 现货价上涨, 部分产品仍有固定需求支撑。**上周 (0226-0303) NAND 颗粒现货价格环比涨跌幅区间为-2.3%~+5.5%, 31 个品类平均涨跌幅为+0.4%, 前值为-0.5%。其中 12 个型号价格持平, 10 个型号价格上涨, 9 个型号价格下跌。NAND 现货价呈现上涨趋势, 且适逢月底月初交际, 需求动能虽有陆续恢复。因市场报价仍是相对偏高, 整体终端需求修复或不如预期, 但在大容量 eMMC 及特定 SSD 仍有固定需求支撑, 随着加上原厂端颗粒及 wafer 陆续到货, 市场卖压形成, 整体氛围呈现价格修正。
- 模组端: 23Q4 DRAM 与 NAND 市场规模环比显著增长, 修复态势强劲。**据 CFM 闪存市场数据显示, 2023 年四季度全球 NAND Flash 市场规模环比 24.6% 至 122.3 亿美元, DRAM 市场规模环比增长 32.1% 至 172.6 亿美元, 四季度全球存储市场规模再度环比增长 28.9% 至 294.8 亿美元, 同比恢复增长到 30.2%。整体来看, 全球存储市场规模在 2023 年一季度、二季度、三季度、四季度分别环比减少 20%、增长 9%、增长 16% 和增长 29%, 不过全年存储市场规模依然同比减少 35% 至 903.7 亿美元。(1) NAND: NAND Flash 平均价格在四季度明显改善, 带动各原厂四季度收入增长, 尤其是三星和 SK 海力士在四季度的 NAND Flash 收入增长超过 30%。而长江存储也策略性增加了在 OEM 市场的供应, 其 2023 年的市场份额也随之扩大。(2) DRAM: 在 HBM、DDR5 以及 LPDDR5 等高价产品出货占比提高的作用下, 四季度各原厂的 DRAM 收入也发生了较大的增长。其中, 从全年来看, SK 海力士在 2023 年的表现最为突出, 并逐渐缩小与三星的差距。
- 相关标的:**
  - 存储模组:** 江波龙 (进军企业级&信创市场)、佰维存储 (研发封测一体化)、朗科科技 (韶关数据中心逐步落地)、德明利 (NAND 主控+模组) 等
  - 存储芯片:** 建议关注兆易创新 (NOR+DRAM 龙头)、东芯股份、普冉股份等
  - DDR5 配套:** 澜起科技、聚辰股份等
- 风险提示:** 下游需求不及预期、行业竞争加剧、全球贸易摩擦风险。

图 1: DRAM 中大容量现货价趋势 (美元)



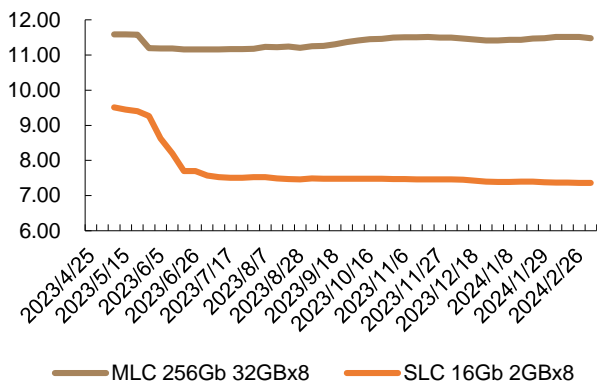
资料来源: DRAMexchange, 德邦研究所

图 2: DRAM 中小容量现货价趋势 (美元)



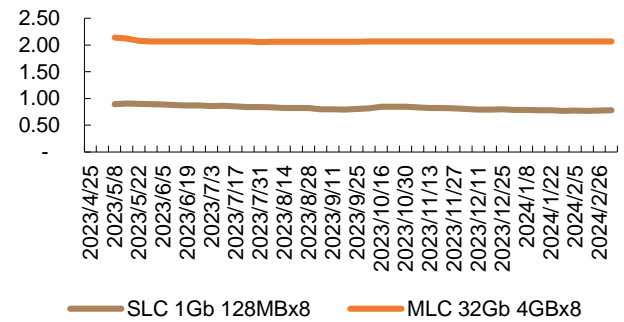
资料来源: DRAMexchange, 德邦研究所

图 3: NAND 中大容量现货价趋势 (美元)



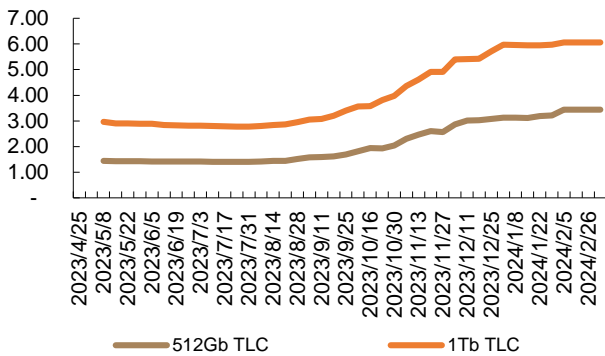
资料来源: DRAMexchange, 德邦研究所

图 4: NAND 中小容量现货价趋势 (美元)



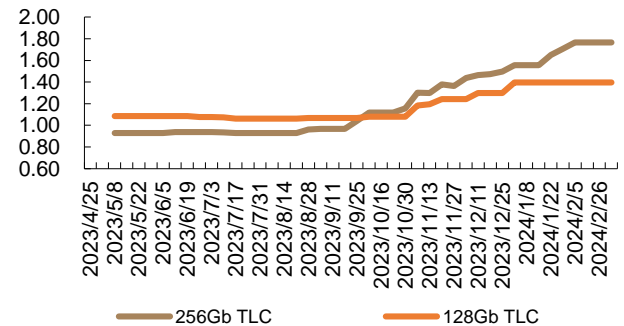
资料来源: DRAMexchange, 德邦研究所

图 5: NANDWafer 中大容量现货价趋势 (美元)



资料来源: DRAMexchange, 德邦研究所

图 6: NANDWafer 中小容量现货价趋势 (美元)



资料来源: DRAMexchange, 德邦研究所

# 信息披露

## 分析师与研究助理简介

陈海进，德邦证券所长助理兼 TMT 组组长、电子首席分析师，8 年以上电子行业研究经验，曾任职于民生证券、方正证券、中欧基金等，南开大学国际经济研究所硕士。电子行业全领域覆盖。

徐巡，电子行业研究助理，上海交通大学经济学硕士，2 年以上电子行业研究经验，曾任职于凯盛研究院，覆盖 IC 设计、半导体设备与制造等领域。

谢文嘉，电子行业研究助理，香港大学硕士，覆盖模拟 IC 设计、数字 IC 设计等领域。

## 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准：	类别	评级	说明
以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅；	股票投资评级	买入	相对强于市场表现 20%以上；
		增持	相对强于市场表现 5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现 5%以下。
2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

## 法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。